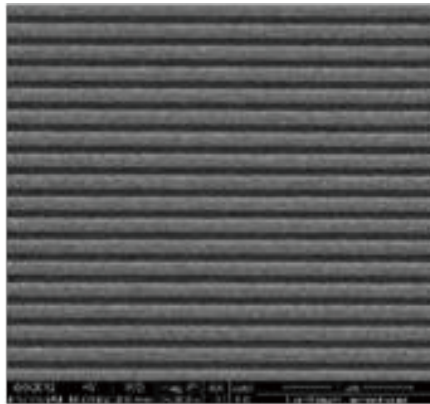




Lightsmyth 纳米图案硅图章



产品描述

LightSmyth 提供了大量的纳米加工单晶硅衬底，为工业和学术机构提供了一个低成本的纳米光子学研究入口。基底可用于光学、光子学、生物学、化学、物理学（如中子散射）、聚合物研究、纳米印迹、微流体学等领域。如果需要，基板可以涂上金属或介质涂层。大多数地表特征具有略微梯形的横截面轮廓，具有直线平行的台地和沟渠。晶格状结构也可用。提供了许多特征尺寸和沟槽深度。基板的扫描电镜图像可以在装运前拍摄，以验证准确的轮廓。

表中显示的维度表示目标值。周期精度优于 0.5%，槽深、线宽、间距与目标值相差 15%。文中给出了扫描电镜图。如果需要更精确的尺寸信息，LightSmyth 可以提供您订购的特定纳米棉片的扫描电镜，作为可选服务。

产品参数

描述	数据
基材宽度高度误差	标准公差 $\pm 0.2\text{mm}$
净孔径 (CA)	距基板边缘 0.5 mm（图案可延伸至基板边缘）
基底厚度	0.675 ± 0.050 mm
CA 的表面质量	P/N 以 “p” 结尾：划痕/挖：最大划痕宽度，最大最大直径。可提供高达 20/10 的规格
CA 的表面质量	P/N 以 “S” 结尾：由于表面质量而打折的等级。至少有 80% 的可用面积。可能出现 80/100 划痕/挖痕/颗粒和不规则基底形状
CA 外表面质量	无要求
Material 材料	单晶硅，反应离子刻蚀





Linear Nanostamps (line+space)

型号	间隔 (nm)	槽深 (nm)	占空 比	线宽 (nm)	尺寸 (mm)	SEM link1	Top down
SNS-C72-1212-50-P	139	50	50%	69.5	12.5×12.5×0.7	X-sec	Top down
SNS-C72-2525-50-P	139	50	50%	69.5	25×25×0.75	X-sec	Top down
SNS-C36-1212-110-P	278	110	50%	139	12.5×12.5×0.7	X-sec	Top down
SNS-C24-1212-110-P	416.6	110	50%	208	12.5×12.5×0.7	X-sec	Top down
SNS-C20-0808-150-D 45-P	500	150	44%	220	8×8.3×0.7		Top down
SNS-C20-0808-350-D 45-P	500	350	44%	220	8×8.3×0.7		Top down
SNS-C20-0808-150-D 60-P	500	150	60%	300	8×8.3×0.7		Top down
SNS-C20-0808-350-D 60-P	500	350	60%	300	8×8.3×0.7		Top down
SNS-C18-2009-110-D 50-P	555.5	110	50%	278	20×9×0.7	X-sec	Top down
SNS-C18-2009-140-D 50-P	555.5	140	50%	278	20×9×0.7	X-sec	Top down
SNS-C18-2009-110-D 29-P	555.5	110	29%	158	20×9×0.7	X-sec	Top down
SNS-C18-2009-140-D 29-P	555.5	140	29%	158	20×9×0.7	X-sec	Top down
SNS-C16.7-0808-150- D45-P	600	150	43%	260	8×8.3×0.7		Top down
SNS-C16.7-0808-350- D45-P	600	350	43%	260	8×8.3×0.7		Top down
SNS-C16.7-0808-150- D55-P	600	150	55%	330	8×8.3×0.7		Top down
SNS-C16.7-0808-350- D55-P	600	350	55%	330	8×8.3×0.7		Top down
SNS-C16.5-2912-190- P	606	190	50%	303	29×12×0.7	X-sec	Top down
SNS-C16.5-2912-190- S4	606	190	50%	303	29×12×0.7	X-sec	Top down
SNS-C16.5-2924-190- P	606	190	50%	303	29×24.2×0.75	X-sec	Top down
SNS-C14.8-2410-170- P	675	170	32%	218	24×10×0.7		
SNS-C14.8-2430-170- P	675	170	32%	218	24×30.4×0.75		





SNS-C14.3-0808-150-D45-P	700	150	47%	330	8×8.3×0.7		Top down
SNS-C14.3-0808-350-D45-P	700	350	47%	330	8×8.3×0.7		Top down
SNS-C14.3-0808-150-D55-P	700	150	55%	375	8×8.3×0.7		Top down
SNS-C14.3-0808-150-D55-P	700	150	55%	375	8×8.3×0.7		Top down
SNS-C12-1212-200-P	833.3	200	50%	416	12.5×12.5×0.7	X-sec	Top down
SNS-C12-2525-200-P	833.3	200	50%	416	25×25×0.7	5 X-sec	Top down
SNS-C11.7-1212-200-P	855	200	50%	428	12.5×12.5×0.7		
SNS-C11.7-2525-200-P	855	200	50%	428	25×25×0.7	5	

2D nanostamps (rectangular and hexagonal lattice)

型号	间隔 (nm)	槽深 (nm)	占空比	线宽 (nm)	尺寸	型号
S2D-24B3-0808-150-P	700	rect post	150	260	8×8.3×0.7	Top down
S2D-24B3-0808-350-P	700	rect post	350	260	8×8.3×0.7	Top down
S2D-18B3-0808-150-P	700	rect post	150	350	8×8.3×0.7	Top down
S2D-18B3-0808-350-P	700	rect post	350	350	8×8.3×0.7	Top down
S2D-24C2-0808-150-P	600	hex post	150	165	8×8.3×0.7	Top down
S2D-24C2-0808-350-P	600	hex post	350	165	8×8.3×0.7	Top down
S2D-18C2-0808-150-P	600	hex post	150	240	8×8.3×0.7	Top down
S2D-18C2-0808-350-P	600	hex post	350	240	8×8.3×0.7	Top down
S2D-24C3-0808-150-P	700	hex post	150	220	8×8.3×0.7	Top down
S2D-24C3-0808-350-P	700	hex post	350	220	8×8.3×0.7	Top down
S2D-18C3-0808-150-P	700	hex post	150	290	8×8.3×0.7	Top down
S2D-18C3-0808-350-P	700	hex post	350	290	8×8.3×0.7	Top down
S2D-24D2-0808-150-P	600	hex hole	150	180	8×8.3×0.7	Top down





S2D-24D2-0808-350-P	600	hex hole	350	180	$8 \times 8.3 \times 0.7$	Top down
S2D-18D3-0808-150-P	700	hex hole	150	200	$8 \times 8.3 \times 0.7$	Top down
S2D-18D3-0808-350-P	700	hex hole	350	200	$8 \times 8.3 \times 0.7$	Top down
S2D-24D3-0808-150-P	700	hex hole	150	290	$8 \times 8.3 \times 0.7$	Top down
S2D-24D3-0808-350-P	700	hex hole	350	290	$8 \times 8.3 \times 0.7$	Top down

New nanostamps are added to our stock frequently. Please contact our application scientists if you cannot find a nanostructure you need in our stock list.

如何清洁光栅

为了去除油脂和其他污染物, 传输光栅可在室温 Liquinox 溶液中浸泡不超过 5 分钟, 在三个蒸馏水中漂洗, 并使用无油喷嘴用干净干燥的压缩氮气吹干, 同时用镊子夹住格栅 (不要使用罐上的灰尘, 因为其排放物受到高度污染)。切勿让水在格栅表面干燥, 应将其吹走。氮气应该来自油箱或无油压缩机。

<http://www.alconox.com/Resources/TechnicalBulletin.aspx?plid=3>

为了在这个过程中固定光栅, 可以使用 Nalgene™ 聚丙烯剪刀式镊子。

<http://www.thermoscientific.com/en/product/nalgene-polypropylene-scissor-type-forceps.html>

订购型号

型号	描述	单价
SNS-C11.7-2525-200-P	线性硅纳米印章: 周期 855nm, 槽深 200nm, 占空比 50%, 尺寸 25.0x 25.0 mm	RMB4750
SNS-C14.3-0808-150-D45-P	线性硅纳米印章: 周期 700nm, 槽深 150nm, 占空比 47%, 尺寸 8.0x 8.3mm	RMB2350
SNS-C14.3-0808-150-D55-P	线性硅纳米印章: 周期 700nm, 槽深 150nm, 占空比 55%, 尺寸 8.0x 8.3mm	RMB2350
SNS-C14.3-0808-350-D45-P	线性硅纳米印章: 周期 700nm, 槽深 350nm, 占空比 47%, 尺寸 8.0x 8.3mm	RMB2350





SNS-C14.3-0808-350-D55-P	线性硅纳米印章: 周期 700nm, 槽深 350nm, 占 空比 55%, 尺寸 8.0x 8.3mm	RMB2350
SNS-C14.8-2410-170-P	线性硅纳米印章: 周期 675nm, 槽深 170nm, 占 空比 32%, 尺寸 24.0x 10.0 mm	RMB2950
SNS-C14.8-2430-170-P	线性硅纳米印章: 周期 675nm, 槽深 170nm, 占 空比 32%, 尺寸 24.0x 30.4mm	RMB4750
SNS-C16.5-2912-190-P	线性硅纳米印章: 周期 606nm, 槽深 190nm, 占 空比 50%, 尺寸 29.15x 12.15mm	RMB2950
SNS-C16.5-2924-190-P	线性硅纳米印章: 周期 606 nm, 槽深 190 nm, 占空 比 50%, 尺寸 29.15 x 24.35 mm	RMB4750
SNS-C16.5-5050-190-P	线性硅纳米印章: 周期 606 nm, 槽深 190 nm, 占空 比 50% (303 nm 线宽) , 尺寸 50.0 x 50.0 mm, 净 孔径 49x49 mm。	RMB1,9500
SNS-C16.7-0808-150-D45-P	线性硅纳米印章: 周期 600 纳米, 槽深 150 纳米, 占 空比 43%, 尺寸 8.0 x 8.3 mm	RMB2350
SNS-C16.7-0808-150-D55-P	线性硅纳米印章: 周期 600 nm, 槽深 150 nm, 占空 比 55%, 尺寸 8.0 x 8.3 mm	RMB2350
SNS-C16.7-0808-350-D45-P	线性硅纳米印章: 周期 600 nm, 槽深 350 nm, 占空 比 43%, 尺寸 8.0 x 8.3 mm	RMB2350
SNS-C16.7-0808-350-D55-P	线性硅纳米印章: 周期 600 nm, 槽深 350 nm, 占空 比 55%, 尺寸 8.0 x 8.3 mm	RMB2350
SNS-C18-2009-110-D29-P	线性硅纳米印章: 周期 555nm, 槽深 110nm, 占 空比 29%, 尺寸 20.0x 9 mm	RMB2350
SNS-C18-2009-110-D50-P	线性硅纳米印章: 周期 555nm, 槽深 110nm, 占 空比 50%, 尺寸 20.0x 9	RMB2350





	mm	
SNS-C18-2009-140-D29-P	线性硅纳米印章: 周期 555nm, 槽深 140nm, 占空比 29%, 尺寸 20.0x 9 mm	RMB2350
SNS-C18-2009-140-D50-P	线性硅纳米印章: 周期 555nm, 槽深 140nm, 占空比 50%, 尺寸 20.0x 9 mm	RMB2350
SNS-C20-0808-150-D45-P	线性硅纳米印章: 周期 500 nm, 槽深 150 nm, 占空比 44%, 尺寸 8.0 x 8.3 mm	RMB2350
SNS-C20-0808-150-D60-P	线性硅纳米印章: 周期 500 nm, 槽深 150 nm, 占空比 60%, 尺寸 8.0 x 8.3 mm	RMB2350
SNS-C20-0808-350-D45-P	线性硅纳米印章: 周期 500 nm, 槽深 350 nm, 占空比 44%, 尺寸 8.0 x 8.3 mm	RMB2350
SNS-C20-0808-350-D60-P	线性硅纳米印章: 周期 500 nm, 槽深 350 nm, 占空比 60%, 尺寸 8.0 x 8.3 mm	RMB2350
SNS-C24-1212-110-P	线性硅纳米印章: 周期 417nm, 槽深 110nm, 占空比 50%, 尺寸 12.5x 12.5mm	RMB2350
SNS-C36-1212-110-P	线性硅纳米印章: 周期 278nm, 槽深 110nm, 占空比 50%, 尺寸 12.5x 12.5mm	RMB2350
SNS-C72-1212-50-P	线性硅纳米印章: 周期 139 nm, 槽深 50 nm, 占空比 50%, 尺寸 12.5 x 12.5 mm	RMB2950
SNS-C72-2525-50-P	线性硅纳米印章: 周期 139 nm, 槽深 50 nm, 占空比 50%, 尺寸 25.0 x 25.0 mm	RMB9850

